

# 2N5551

Rev.F Mar.-2016

## 描述 / Descriptions

TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

## 特征 / Features

击穿电压高,可与 2N5401 互补。

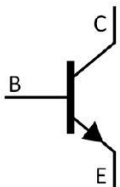
High voltage, complementary Pair with 2N5401.

## 用途 / Applications

用于普通高压放大。

General purpose high voltage amplifier.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Collector      PIN 2 : Base      PIN 3 : Emitter

## 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	A	B	C
$h_{FE}$ Range	50~150	100~300	200~400

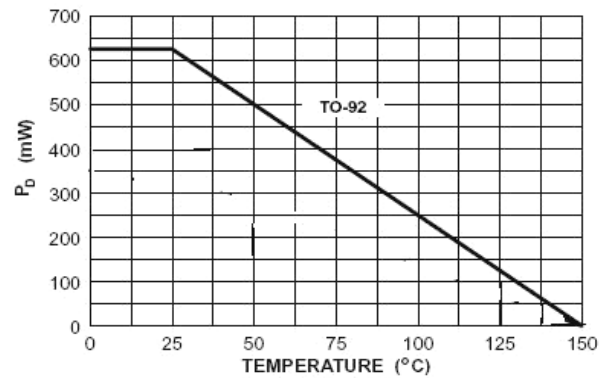
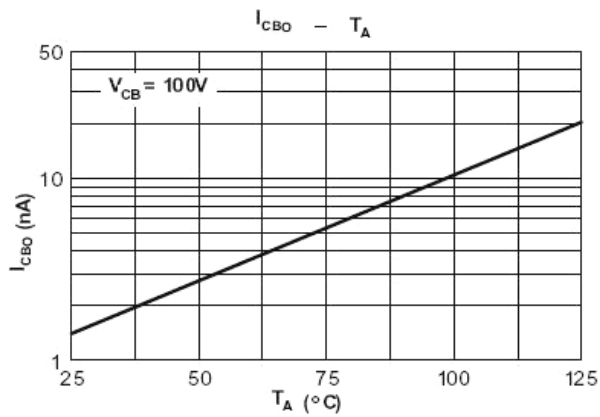
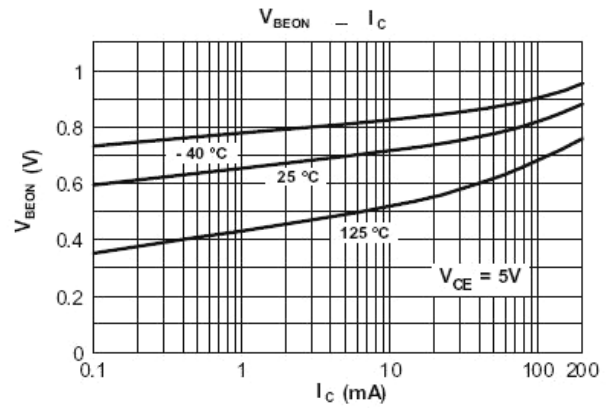
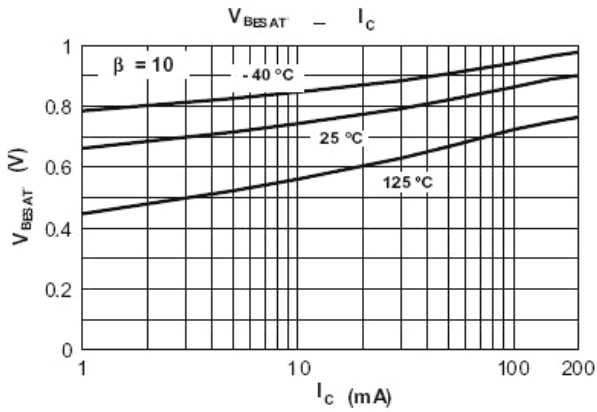
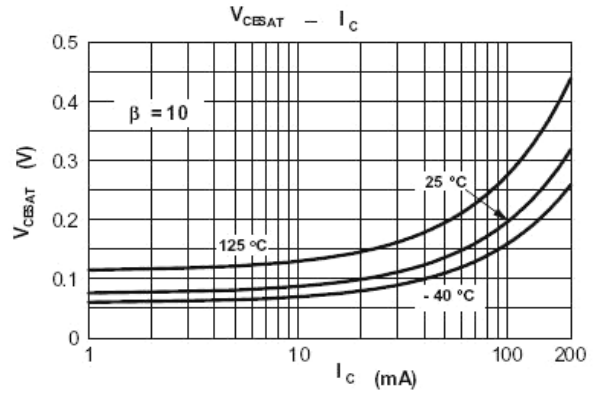
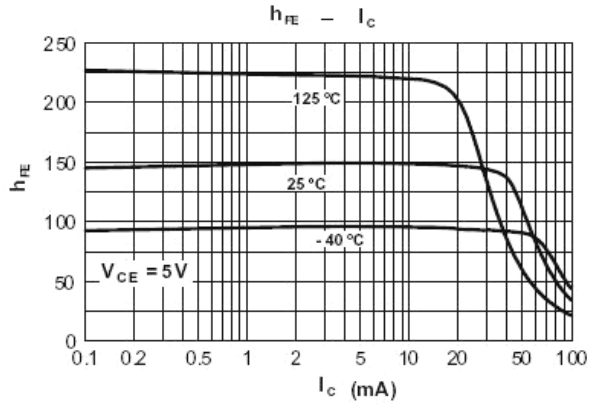
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	180	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	160	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	6.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	600	mA
Base Current - Continuous	$I_B$	300	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	625	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=180V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=6.0V$ $I_C=0$			0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$	50	200	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=50mA$	20	160		
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	40	190		
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.06	0.15	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.09	0.3	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.7	1.0	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.8	1.0	V
Base to Emitter Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$		0.68	0.75	V
Current Gain Bandwidth Product	$f_T$	$V_{CE}=10V$ $I_C=10mA$	50	110		MHz
Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		2.2	5.0	pF
Turn On Time	$t_{on}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.3		$\mu s$
Turn Off Time	$t_{off}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.4		$\mu s$
Storage Time	$t_{stg}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.2		$\mu s$

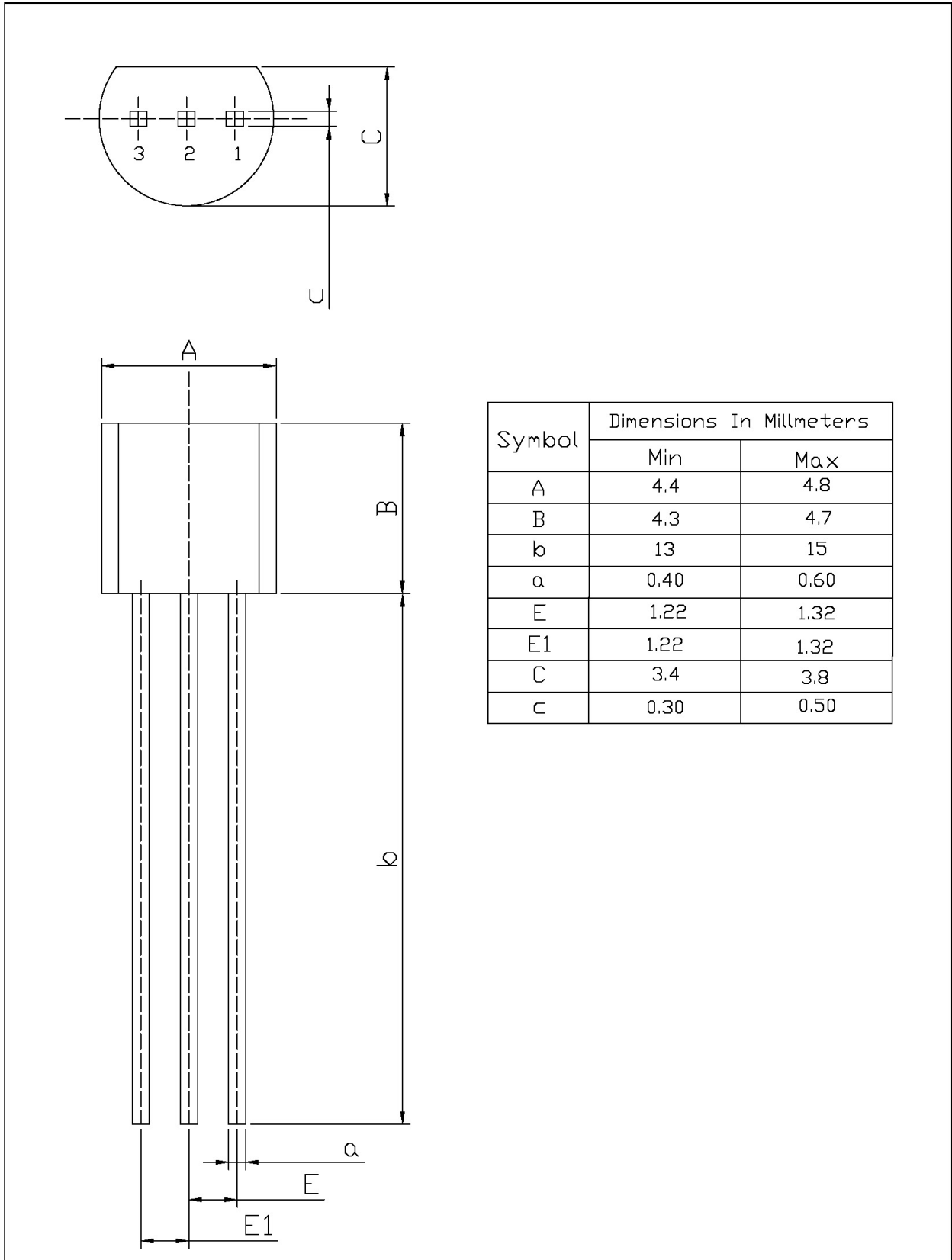
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



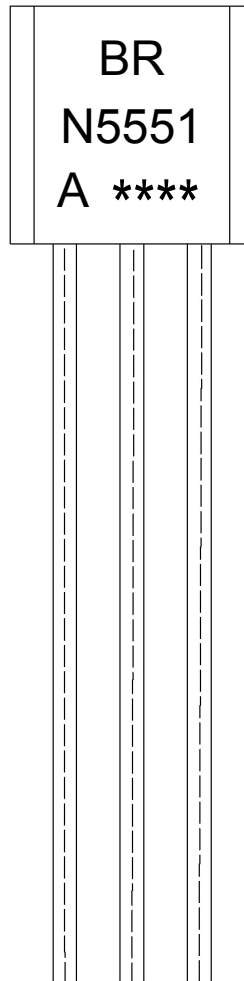
外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-92

Unit: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

N5551： 为型号代码

A： 为  $h_{FE}$  分档代码

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

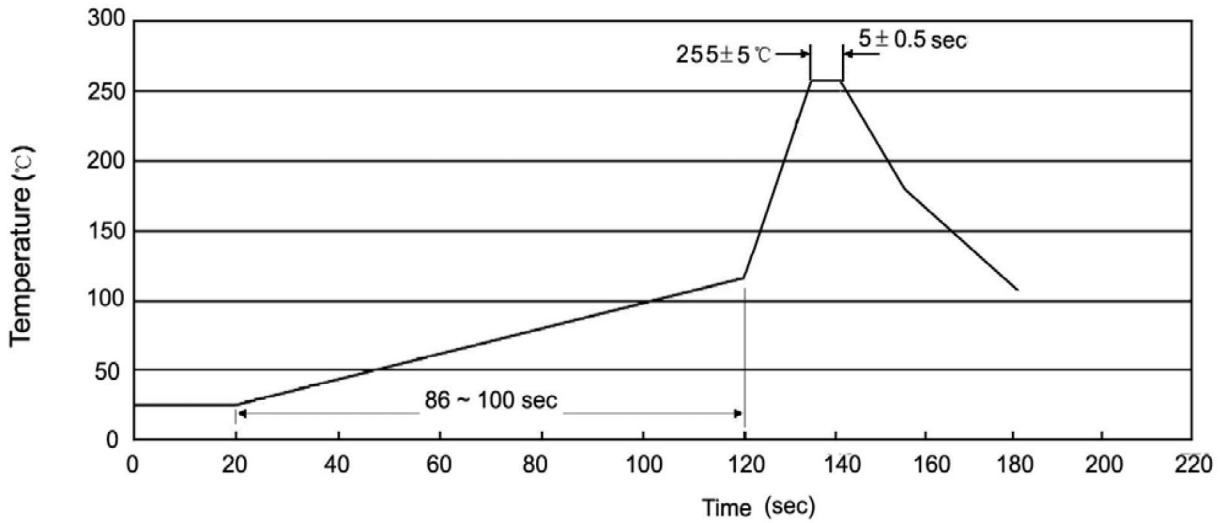
BR: Company Code.

N5551: Product Type Code.

A:  $h_{FE}$  Classifications Symbol.

\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

**波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

**使用说明 / Notices**